PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-124124

(43)Date of publication of application: 28.04.2000

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 G03F 7/30

(21)Application number: 10-316858

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing:

20.10.1998

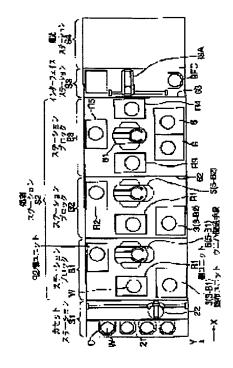
(72)Inventor: KIMURA YOSHIO

UEDA KAZUNARI

(54) SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable resist application units that apply resist to a substrate to be increased in number so as to obtain high throughput for a substrate processing device, in a resist applying and developing device that applies resist on the surface of a substrate and develops the substrate after it is exposed to light. SOLUTION: Two station blocks B1 and B2 which apply resist on wafers are connected to a cassette station S1. where wafer cassettes are loaded or unloaded, and furthermore a station block B3 which carries out a developing process is also connected to the cassette station S1. The station blocks B1 and B2 are substantially identical in constitution, and each equipped with an application unit 3 and a wafer transfer means 5, and the wafer transfer means 5-B1 of the station block B1 is so structured as to deliver wafers to both the application unit 3-B1 and the application unit 3-B2 of the station block B2 which is adjacent to the station block 5-B1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3442669

[Date of registration]

20.06.2003

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-124124 (P2000-124124A)

(43)公開日 平成12年4月28日(2000.4.28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 1 L 21/027		H01L 21/30	564C 2H096
G03F 7/30	502	G 0 3 F 7/30	502 5F046

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 9 頁)

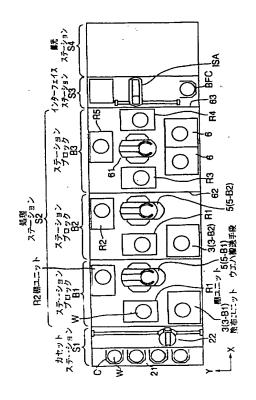
(21)出願番号	特願平10-316858	(71) 出願人 000219967
		東京エレクトロン株式会社
(22)出願日	平成10年10月20日(1998.10.20)	東京都港区赤坂5丁目3番6号
		(72)発明者 木村 義雄
		熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京
		エレクトロン九州株式会社熊本事業所内
		(72)発明者 上田 一成
		熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京
		エレクトロン九州株式会社熊本事業所内
		(74)代理人 100091513
		弁理士 井上 俊夫 (外1名)
		Fターム(参考) 2H096 AA25 CA14 FA01 GA31
		5F046 DA29 JA04 JA22 KA01 KA07
		LAO4 LA18

(54) 【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【課題】 例えばレジストを基板表面に塗布し、露光後の基板を現像処理する塗布、現像装置において、レジストを塗布する塗布ユニットの数を増やすにあたって高いスループットを得ること。

【解決手段】 ウエハカセットを搬入出するカセットステーションS1に、レジストの塗布を行う例えば2つのステーションプロックB1、B2を接続し、更に現像を行うステーションプロックB3を接続する。ステーションプロックB1、B2は例えば実質同一の構成とされ、いずれも1個の塗布ユニット3及び1基のウエハ搬送手段5を備えており、ステーションプロックB1の企業を開発を開発した。自己のステーションプロックB1の塗布ユニット3-B1と隣りのステーションプロックB2の塗布ユニット3-B2とに対してウエハWの受け渡しができるように構成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 複数の基板を収納した基板カセットを載置する載置部と、この載置部に載置された基板カセットに対して基板の受け渡しをする受け渡し手段と、を含むカセットステーションと、このカセットステーションに接続され、前記受け渡し手段により搬送された基板を処理する処理ステーションと、を有し、

(b) 前記処理ステーションは、複数のステーションプロックを接続してなり、各ステーションプロックは、基板を処理する処理ユニットと、この処理ユニットに対して基板の受け渡しをする基板搬送手段と、を含み、

(c) ステーションブロックの少なくとも一つは、基板 搬送手段が自己のステーションブロックの処理ユニット と隣接のステーションブロックの処理ユニットとの両方 に対して基板の受け渡しができるように構成されている ことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】 処理ステーションは、互いに隣接して接続される k番目 (kは1以上の整数) のステーションブロックと (k+1) 番目のステーションブロックとを有しており、

k番目のステーションブロックは、基板搬送手段が自己のステーションブロックの処理ユニットと(k+1)番目のステーションブロックの処理ユニットとの両方に対して基板の受け渡しができるように構成され、

k番目及び(k+1)番目のステーションブロックは、 基板搬送手段及び処理ユニットの配置のレイアウトが同 一であることを特徴とする請求項1記載の基板処理装 置。

【請求項3】 (a) 複数の基板を収納した基板カセットを載置する載置部と、この載置部に載置された基板カセットに対して基板の受け渡しをする受け渡し手段と、を含むカセットステーションと、このカセットステーションに接続され、前記受け渡し手段により搬送された基板を処理する処理ステーションと、を有し、

(b) 前記処理ステーションは、複数のステーションブロックを接続してなり、各ステーションブロックは、基板を処理する処理ユニットと、この処理ユニットに対して基板の受け渡しをする基板搬送手段と、を含み、

(c) ステーションブロックの少なくとも一つは、平面的に互いに離れて配置された第1及び第2の処理ユニットと、これら第1及び第2の処理ユニットの両方に対して基板の受け渡しを行うことができる第1の基板搬送手段と、これら第1及び第2の処理ユニットの一方の処理ユニットに対して基板の受け渡しができるように構成された第2の基板搬送手段と、を有することを特徴とする基板処理装置。

【請求項4】 処理ユニットは、基板に対して塗布液を 塗布処理するものであることを特徴とする請求項1、2 または3記載の基板処理装置。

【請求項5】 前記(c)の如く構成されたステーショ st

ンプロック内の処理ユニットは、レジスト液を基板に塗 布処理するものであり、

カセットステーション側から数えて最終段のステーションプロック側には露光装置が接続され、当該最終段のステーションプロック内の処理ユニットは、前記露光装置にて露光された基板に対して現像処理するものであることを特徴とする請求項1、2または3記載の基板処理装置。

【請求項6】 最終段のステーションブロックは、当該ステーションブロック専用の清浄気体フィルタユニットを備えており、周囲が壁部で囲まれていてブロック内が閉じられた空間であることを特徴とする請求項5記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体ウエハや液晶ディスプレイ用のガラス基板などの基板に対して例えば塗布液の塗布処理などを行う基板処理装置に関する。

20 [0002]

【従来の技術】半導体デバイスの製造工程におけるフォトリソグラフィー技術においては半導体ウエハ(以下ウエハという)の表面にレジストを塗布し、この塗布レジストを所定パターンに露光処理し、更に現像処理して所定パターンのレジスト膜が形成される。このような一連の処理は、塗布/現像部に露光部を接続した装置により行われる。

【0003】図9及び図10はこのような装置の従来例 を示す概観図であり、基板例えば半導体ウエハを25枚 収納した基板力セットCはカセットステーションA1の カセットステージ1に搬入される。カセットステーショ ンA1には処理ステーションA2が接続されており、処 理ステーションA2にはインターフェイスステーション A3を介して露光ステーションA4が接続されている。 前記カセットステージ1上のカセットC内のウエハW は、受け渡しアーム11により取り出されて処理ステー ションA2に送られる。処理ステーションA2は、ウエ ハWが多段に載置される棚ユニットを3個(12、1 3、14) 備えており、棚ユニット12、13、14の 各棚は、加熱部、冷却部、ウエハWの受け渡し部などと して構成されている。更に処理ステーションA2はウエ ハWにレジスト液を塗布する塗布ユニット15、露光後 のウエハWを現像する現像ユニット16及びウエハ搬送 手段17を備えている。

【0004】ウエハ搬送手段17は、進退自在、水平方向に回転自在、昇降自在に構成されており、棚ユニット12の中の受け渡し部を通じて受け取ったウエハWを棚ユニット12、13、14(例えば加熱部や冷却部や疎水化部など)と塗布ユニット15との間で搬送し、また棚ニニット13の中の受け渡し部を通じて受け取った露

光後のウエハWを棚ユニット12、13、14の加熱部や冷却部と現像ユニット16との間で搬送する。なお18は受け渡しアームである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述の塗 布、現像装置の使い方として、例えばレジスト液の塗布 ユニット15の数を増やす場合があり、処理ユニットA 2には塗布ユニット15だけを配置し、次段に別の処理 ステーションを継ぎ足すことがある。この場合1基のウ エハ搬送手段17に対して塗布ユニット15を上下に4 個配置して処理を行うとウエハWの搬送が追いつかなく なってスループットが落ちるため、一つの処理ステーシ ョンには2個の塗布ユニットと1基のウエハ搬送手段1 7を持たせて、その処理ステーションを複数接続すると いう考え方も検討されている。しかしながらその場合ウ エハWは、一の処理ステーションのウエハ搬送手段→受 け渡し部→隣りの処理ステーションのウエハ搬送手段→ **塗布ユニットの経路で流れるため、ウエハWの受け渡し** に時間がかかり、スループットが低くなるという課題が ある。

【0006】本発明は、このような事情の下になされたものであり、その目的は、基板を処理する処理ユニット及び基板の搬送手段を備えた処理ステーションを用いて基板の処理を行う装置において、スループットの高い処理を行うことのできる装置を提供することにある。また本発明の他の目的は、スループットの高い装置を組立てる上で製造、組立が容易な装置を提供することにある。【0007】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係る基 板処理装置は、(a)複数の基板を収納した基板カセッ トを載置する載置部と、この載置部に載置された基板力 セットに対して基板の受け渡しをする受け渡し手段と、 を含むカセットステーションと、このカセットステーシ ョンに連設され、前記受け渡し手段により搬送された基 板を処理する処理ステーションと、を有し、(b) 前記 処理ステーションは、複数のステーションブロックを接 続してなり、各ステーションブロックは、基板を処理す る処理ユニットと、この処理ユニットに対して基板の受 け渡しをする基板搬送手段と、を含み、(c)ステーシ ョンプロックの少なくとも一つは、基板搬送手段が自己 のステーションプロックの処理ユニットと隣接のステー ションブロックの処理ユニットとの両方に対して基板の 受け渡しができるように構成されていることを特徴とす る。このような構成によれば、一のステーションブロッ ク内に送られた基板は、当該ステーションプロック内の 処理ユニットが塞がっていれば、隣りのステーションブ ロックの処理ユニットに基板搬送手段により直接に搬送 されるので、処理ユニットの数を増やすにあたって、高 いスループットを確保できる。

【0008】請求項2の発明は、上述の発明において、

処理ステーションは、互いに隣接して接続される k 番目 (k は 1 以上の整数) のステーションプロックと (k + 1) 番目のステーションプロックとを有しており、 k 番目のステーションプロックは、基板搬送手段が自己のステーションプロックの処理ユニットと(k + 1) 番目のステーションプロックの処理ユニットとの両方に対して基板の受け渡しができるように構成され、 k 番目及び (k + 1) 番目のステーションプロックは、基板搬送手

段及び処理ユニットの配置のレイアウトが同一であることを特徴とする。この発明によれば、ステーションブロックをいわば汎用化でき、これらをシステムに応じて所望の数だけ接続すればよいので、製造及び組み立てが用意である。

【0009】また請求項3の発明に係る基板処理装置 は、(a)複数の基板を収納した基板カセットを載置す る載置部と、この載置部に載置された基板力セットに対 して基板の受け渡しをする受け渡し手段と、を含むカセ ットステーションと、このカセットステーションに連設 され、前記受け渡し手段により搬送された基板を処理す る処理ステーションと、を有し、(b)前記処理ステー ションは、複数のステーションブロックを接続してなり 各ステーションプロックは、基板を処理する処理ユニッ トと、この処理ユニットに対して基板の受け渡しをする 基板搬送手段と、を含み、(c)ステーションブロック の少なくとも一つは、平面的に互いに離れて配置された 第1及び第2の処理ユニットと、これら第1及び第2の 処理ユニットの両方に対して基板の受け渡しを行うこと ができる第1の基板搬送手段と、これら第1及び第2の 処理ユニットの一方の処理ユニットに対して基板の受け 渡しができるように構成された第2の基板搬送手段と、 を有することを特徴とする。

【0010】これら発明において、処理ユニットは、例えば基板に対して塗布液を塗布処理するものである。具体例を挙げると、前記(c)の如く構成されたステーションブロック内の処理ユニットは、レジスト液を基板に塗布処理するものであり、カセットステーション側には露光装板に分が接続され、当該最終段のステーションブロック内の処理ユニットは、前記露光装置にて露光された基板に対り、前記露光装置にて露光された基板に対して現像処理するものである構成である。この場合、最終のステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロックは、当該ステーションブロック内が閉じられた空間である構成とすることができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下に本発明を基板の塗布、現像装置に適用した実施の形態について説明する。図1はこの実施の形態の概略平面図、図2は内部を透視して示す概観図である。図中S1はカセットステーション、S2は処理ステーション、S3はインターフェイスステーシ

ョン、S4は露光ステーションである。

【0012】カセットステーションS1は、複数の基板 例えば25枚のウエハWを収納した基板カセットである ウエハカセット(以下単にカセットという) Cを載置するカセットステージ21と、カセットステージ21上の カセットCと後述の受け渡し部との間でウエハWの受け 渡しを行うための受け渡し手段である受け渡しアーム22とを備えている。受け渡しアーム22は、昇降自在、X、Y方向移動自在、鉛直軸まわりに移動自在に構成されている。

【0013】処理ステーションS2は、複数のステーションプロック例えばウエハにレジストを塗布するための2個のステーションプロックB1、B2と、露光後のウエハに対して現像を行うステーションプロックB3とを接続して構成される。カセットステーションS1側から見て1番目のステーションプロックB1及び2番目のステーションプロックB2は各部分の配置のレイアウトも含めて同一の構成であり、処理ユニットである2個の塗布ユニット3と多段の棚を有する2個の棚を有する2個の棚ユニットR1、R2と、基板搬送手段であるウエハ搬送手段5と、を備えている。

【0014】2個の塗布ユニット3は2段に積み重ねて 設けられており、その構成について図3を参照しながら 簡単に述べる。31はカップであり、このカップ31内 に真空吸着機能を有する回転自在なスピンチャック32 が設けられている。このスピンチャック32は昇降機構 33により昇降自在に構成されており、カップ31の上 方側に位置しているときに、前記ウエハ搬送手段5のア ーム51との間でウエハWの受け渡しが行われる。この ウエハWの受け渡しについては、アーム51がカバー3 0に形成された搬送口30aからカバー30内に進入 し、アーム51上のウエハWをスピンチャック32がそ の下方側から相対的に上昇して受け取り、またその逆の 動作によってスピンチャック32側からアーム51に受 け渡される。34は吐出ノズル、35はレジスト液供給 管、36はノズルを水平移動させる支持アームであり、 スピンチャック32上のウエハWの表面に吐出ノズル3 4からレジスト液を滴下し、スピンチャック32を回転 させてレジスト液をウエハW上に仲展させ塗布する。

【0015】ステーションブロックB1、B2内の各部のレイアウトについては、ステーションブロックB1

(B2)内におけるカセットステーションS1側には一方の棚ユニットR1が設けられており、カセットステーションS1から見て棚ユニットR1の奥側にウエハ搬送手段5が配置されている。なお以後の説明ではカセットステーションS1側を手前側、露光ステーションS4側を奥側として述べることにする。他方の棚ユニットR2はカセットステーションS1側から見てウエハ搬送手段5の左側に、また塗布ユニット3はウエハ搬送手段5の左側に、また塗布ユニット3はウエハ搬送手段5の

6

右側に配置されており、搬送手段 5 によって棚ユニット R1、 R2 及び塗布ユニット 3 に対してウエハWの受け 渡しが行われる。

【0016】前記棚ユニットR1(R2)は、図4に示 すようにウエハWを加熱するための加熱部41、ウエハ を冷却する冷却部42、ウエハ表面を疎水化する疎水化 部43が縦に配列されており、一方の棚ユニットR1に おいては、カセットステーションS1の受け渡しアーム 22とステーションプロックB1の搬送手段4との間で ウエハWの受け渡しを行うための受け渡し台を備えた受 け渡し部44とウエハWの位置合わせを行うためのアラ イメント部45とが設けられている。この例では、ステ ーションプロックB1の棚ユニットR1には、アライメ ント部45が設けられ、隣りのステーションプロックB 2の棚ユニットR1にはアライメント部45は設けられ ておらず、この点では両棚ユニットR1、R1の間で差 異があるが、棚ユニットR1を設けるという点では同一 の構成であり、本発明の請求項でいうステーションプロ ックB1、B2が同一の構成であることに相当する。

【0017】前記ウエハ搬送手段 5 は図5 に示すようにウエハWを保持するアーム5 1 と、このアーム5 1 を進退自在に支持する基台5 2 と、この基台5 2 を昇降自在に支持する一対の案内レール5 3、5 4 と、これら案内レール5 3、5 4 と、これら案内レール5 3、5 4 を及び連結部材5 5、5 6 と、案内レール5 3、5 4 を及び連結部材5 5、5 6 よりなる枠体5 7 を鉛直軸周りに回転自在に駆動するために案内レール下端の連結部材5 6 に一体的に取り付けられた回転駆動部5 7 と、案内レール上端の連結部材5 5 に設けられた回転軸部5 8 と、を備えている。

【0018】アーム51は、夫々ウエハWを保持し得るように3段構成になっており、その各格段にそれぞれ設けられた例えば3片の爪部59の上にウエハWの周縁を載せるようになっている。アーム51の基端部は基台56の長手方向に設けられた案内溝50に沿ってスライド移動し得るようになっている。そのスライド移動により取動制御される。また基台52の昇降移動は、図示しない駆動手段により駆動制御される。従ってそれら2つの図示しない駆動手段、案内溝50、前記案内レール53、54及び前記回転駆動部57は、アーム51を鉛直軸周りに回転自在かつ昇降自在かつ進退自在に駆動する駅動部を構成している。なお59aは、アーム51の上にウエハWが有るか無いかを検出する光センサを取り付けたセンサ支持部材であり、基台52に固定されている。

【0019】ステーションプロックB1、B2は、既述のように同一の構成であり、カセットステーションS1 側から見てステーションプロックB2がステーションプロックB1の実側になるようにかつ互に同じ向きになる

ように接続されている。図2においてステーションプロックB1とB2との境界に線が引かれているが、この境界線は壁を示すものではなく床面及び天井部の接合部を便宜上示したものである。そしてこの実施の形態で重要なことは、ステーションプロックB1のウエハ搬送手段5は、自己のステーションプロックB2の塗布ユニット4とはがしてウエハWの受け渡し(アクセス)を行うことができることである。

【0020】ここで説明が容易なようにステーションプ 10 ロックB1内の塗布ユニット3及びウエハ搬送手段5の 符号を夫々3-B1及び5-B1とし、ステーションブ ロックB2内の塗布ユニット3及びウエハ搬送手段5の 符号を夫々3-B2及び5-B2とする。塗布ユニット 3-B1においては、ウエハ搬送手段5-B1に対向す る領域に搬送口30a(図4参照)が形成され、また塗 布ユニット3-B2においてはウエハ搬送手段3-B1 及び3-B2に対向する領域に搬送口30aが形成され ている。そして図6に示すようにウエハ搬送手段5-B 1の回転中心Pは、両塗布ユニット3-B1、3-B2 の各スピンチャック32の中心Qから等距離に位置して おり、アーム51が同じストロークで各スピンチャック 32に対してウエハWの受け渡しができるようになって いる。このことは塗布ユニット3-B2に着目すれば、 両ウエハ搬送手段5-B1、5-B2からウエハWの受 け渡しが可能であることを意味している。

【0021】次いでウエハに対して現像を行うステーションB3について述べると、このステーションB3においては、ステーションプロックB2寄り及びインターフェイスステーションS3寄りに夫々棚ユニットR3、R4が設けられると共に、左側に棚ユニットR5が、また右側に2個ずつ上下に現像ユニット6が夫々設けられている。棚ユニットR3~R5は、既述の棚ユニットR1、R2とほぼ同じ構成であり、加熱部や冷却部が配置されている。ただし棚ユニットR3、R4には、夫々ステーションB2、インターフェイスステーションS3との間でウエハWの受け渡しを行うための受け渡し部が設けられている。

【0022】また現像ユニット6は、図3に示した塗布ユニット3とほぼ同一の構成であるが、例えば現像液供 40給ノズルはウエハWの直径方向に配列された多数の供給孔が設けられている点などに差異がある。前記棚ユニットR3~R5及び現像ユニット6に囲まれた領域の中央部には、例えば既述のウエハ搬送手段5と同様のウエハ搬送手段61が配置されており、棚ユニットR3~R5及び現像ユニット6、6の間でウエハWの搬送を行う。【0023】そしてこのステーションプロックB3は、各ユニットR3~R5及び6が置かれている空間が閉じられている。ここでいう空間が閉じられているとは、左

右が装置本体の外装体である壁部分であり、隣りのステード

ーションプロックB2、インターフェイスステーションS3との間に夫々仕切り壁62、63が設けられ(図1、図7参照)、更に天井部にフィルタユニットFが設けられていて外部からの空気がこのフィルタユニットFを通って中に入っていくように構成されているということである。図7中64はウエハWの受け渡し口である。【0024】フィルタユニットFは、空気を清浄化するためのフィルタ、空気中のアルカリ成分例えばアンモア成分やアミンを除去するために酸成分が添加されている化学フィルタ、及び吸い込みファンなどを備えている。この実施の形態ではレジスト液として化学増幅型のレジストを用いており、このため現像処理雰囲気にアルカリ成分が入り込むことを防止する必要があるので、ステーションプロックB内を閉じた空間とし、化学フィルタを用いて外部からのアルカリ成分の侵入を防いでいる。

【0025】なお化学増幅型のレジストは、露光することにより酸が生成し、この酸が加熱処理により拡散して触媒として作用し、レジスト材料の主成分であるベース樹脂を分解したり分子構造を変えて現像液に対して可溶化するものである。従ってこの種のレジストを用いた場合、空気中に含まれている微量なアンモニアや壁の塗料などから発生するアミンなどのアルカリ成分がレジスト表面部の酸と接触すると、酸による触媒反応が抑制され、パターンの形状が劣化するためアルカリ成分を除去する必要がある。

【0026】装置全体の説明に戻ると、ステーションプロックB3の隣りにはインターフェイスステーションS3が接続され、このインターフェイスステーションS3の奥側には、レジスト膜が形成されたウエハWに対して露光を行うための露光ステーションS4が接続されている。インターフェイスステーションS3は、ステーションプロックB3と露光ステーションS4との間でウエハWの受け渡しを行うための受け渡しアームISAやバッファカセットBFCなどが設けられている。

【0027】次に上述の実施の形態の作用について説明する。先ず自動搬送ロボット(あるいは作業者)により例えば25枚のウエハWを収納したカセットCがカセットステージ21に搬入され、受け渡しアーム22により、カセットC内からウエハWが取り出されてステーションブロックB1の棚ユニットR1内の受け渡し部44内に置かれる。このウエハWは疎水化部43(図5参照)で疎水化された後、塗布ユニット3-B1に搬送され、レジストが塗布される。続いて棚ユニットR1を設まれ、ルジストが塗布される。続いて棚ユニットR1の受け渡し部44を介してウエハ搬送手段5-B2に受け渡される。なおレジストの塗布処理に比べて加熱冷却に要する時間が長いため、加熱部41、冷却部42の数を多くしてある。

【0028】ここでステーションプロックB1の説明に 戻るが、ウエハWが順次棚ユニットR1の受け渡し部4 4に送られ、塗布ユニット3-B1が塞がっているとき には、ウエハ搬送手段5-B1は隣りのステーションプ ロックB2の塗布ユニット3-B2にウエハWを直接搬 送する。そしてレジストが塗布された後、ウエハ搬送手 段5-B2により取り出されて例えばステーションプロ ックB2内の加熱部41、冷却部42に順次搬送され る。なお塗布ユニット3-B1でレジストが塗布された ウエハWは、処理しているロットのウエハ枚数などに応 じて隣りのステーションプロックB2で加熱、冷却する ようにしてもよいし、また塗布ユニット3-B2でレジ ストが塗布されたウエハWは、ウエハ搬送手段5-B1 によりステーションプロックB1内の棚ユニットR1 (R2)に搬送して加熱、冷却するようにしてもよい。 このようにステーションプロックB1あるいはステーシ ョンブロックB2で一連の処理がされたウエハWは、ウ エハ搬送手段5-B2からステーションプロックB3の 棚ユニットR3の受け渡し部44→ウエハ搬送手段61 →棚ユニットR4の受け渡し部44→インターフェイス ステーションS3の受け渡しアームISA→露光ステー ションS4の経路で搬送され、露光ステーションS4に て露光が行われる。

【0029】露光後のウエハWは逆の経路でステーションプロックB3に送られ、例えば化学増幅型のレジストを用いた場合、棚ユニットR3(あるいはR5、R6)にて加熱、冷却され、現像ユニット6にて現像処理される。その後ウエハWはステーションプロックB2を介してB1に送られ、棚ユニットR1の受け渡し部44を介して例えば元のカセットC内に戻される。

【0030】上述実施の形態では、カセットステーショ ンS1からステーションプロックB1に送られたウエハ Wを自己の塗布ユニット3-B1のみならず隣のステー ションプロックB2の塗布ユニット3-B2にも直接受 け渡すことができ、また塗布ユニット3-B2にて処理 されたウエハWは、両ステーションプロックB1、B2 のウエハ搬送手段5-B1、5-B2のいずれからもア クセス可能である。従ってステーションプロック B1の 塗布ユニット3-B1が塞がっている場合には、ステー ションプロックB1から受け渡し部44及び隣りのステ ーションプロックB2のウエハ搬送手段5-B2を介在 させることなく直接塗布ユニット3-B2に受け渡さ れ、その後例えばステーションプロックB2内にて加熱 処理されるため、塗布ユニットの数を増やすにあたっ て、平面的に並べられた例えば2個の塗布ユニット(こ の例では3-B1、3-B2) に夫々専用の2基のウエ ハ搬送手段を設ける場合に比べ、高いスループットを得 ることができる。更にステーションプロックB1、B2 を同一の構成としているので、いわば汎用化されたプロ ックを塗布ユニット3の必要な数に応じて総ぎ足してい 10

けばよいので、製造、組立が容易であり、コスト的にも 有利である。

[0031] 以上において本発明は、レジストの塗布処理を行うステーションブロックB1 (B2) の接続数が2個に限らず3個以上であってもよい。上述の実施の形態に係るステーションブロックB1、B2は夫々特許請求の範囲でいう k番目 (k=1)、 (k+1)番目のステーションブロックに対応するものである。また現像処理を行うステーションブロックB3についても適宜継ぎ足していくようにしてもよい。

【0032】更に、図8は他の実施の形態を示す図である。この例は、先の実施の形態のステーションプロックB1、B2を一つのプロックC1として構成したものつまり構造的に一体化したものであり、他の部分は先の実施の形態と同様である。棚ユニット、塗布ユニット及びウエハ搬送手段については変わるところがないので、既述の符号と同一の符号を付してある。なお特許請求の範囲の記載と対応させると、カセットステーションS1に近い方の塗布ユニット3(3-1)が第1の処理ユニットに、他方の塗布ユニット3(3-2)が第2の処理ユニットに夫々相当する。またカセットステーションS1に近い方のウエハ搬送手段5(5-1)が第1の基板搬送手段に、他方のウエハ搬送手段5(5-2)が第2の基板搬送手段に夫々相当する。

【0033】このような実施の形態においてもウエハ搬送手段5(5-1)が両方の塗布ユニット3(3-1,3-2)に対してウエハの受け渡しを行うことができるので、塗布ユニットの数を増やしながら、高いスループットが得られる。

【0034】なお本発明ではステーションプロックB1 (B2) あるいはC1内に塗布ユニット3と現像ユニッ ト6とを混在させてもよいし、ステーションプロックB 3内に塗布ユニット3と現像ユニット6とを混在させて もよい。また現像処理を行うステーションプロックB3 は、開放されていてもよく、例えばステーションブロッ クB2との間に仕切り壁がなくともよい。そしてまたス テーションプロックB2のウエハ搬送手段5-B2はス テーションブロックB3内の現像ユニット3に対しても ウエハWの受け渡しができるように構成してもよい。基 板としてはウエハに限らず液晶ディスプレイ用のガラス 基板であってもよい。また本発明は塗布、現像装置に限 らず、例えばSi〇ヮの前駆物質の溶液をウエハ上にス ピンコーティングにより塗布する塗布ユニットを処理ス テーションに設け、塗布後のウエハを加熱してSiO2 膜を形成する塗布装置に適用してもよい。

[0035]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、処理ユニットを複数備えた基板処理装置において高いスループットを得ることができるという効果がある。また処理ユニットを含む同一構成のステーションブロックを複数接続

(7)

11

する構成を採用することによってステーションブロック を汎用化できるので製造、組立が容易でコスト的にも有 利であるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る塗布、現像装置を示す概観図である。

【図2】本発明の実施の形態に係る塗布、現像装置を示す概略平面図である。

- 【図3】塗布ユニットを示す断面図である。
- 【図4】棚ユニットを示す側面図である。
- 【図5】ウエハ搬送手段を示す斜視図である。
- 【図6】ウエハ搬送手段が塗布ユニットに対してウエハ の受け渡しを行う様子を示す概略平面図である。

【図7】現像を行うためのステーションブロックを示す 概観図である。

【図8】本発明の他の実施の形態に係る塗布、現像装置 を示す概略平面図である。

【図9】従来の塗布、現像装置を示す概観図である。

【図10】従来の塗布、現像装置を示す概略平面図である。

【符号の説明】

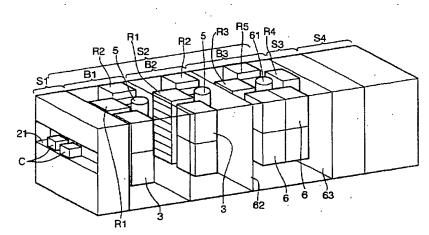
- S1 カセットステーション
- S2 処理ステーション
- S3 インターフェイスステーション

12

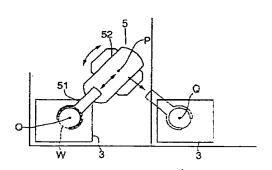
- S4 露光ステーション
- W ウエハ
- C ウエハカセット
- 21 カセットステージ
- 22 受け渡しアーム
- 10 B1~B3 ステーションブロック
 - 3 塗布ユニット
 - 30a 搬送口
 - 32 スピンチャック
 - R1~R5 棚ユニット
 - 5 ウエハ搬送手段
 - 51 アーム
 - 5 2 基台
 - 6 現像ユニット
 - 61 ウエハ搬送手段
- 20 C1 ステーションプロック

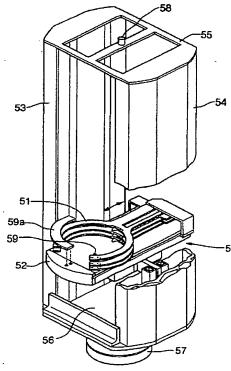
【図1】

【図5】

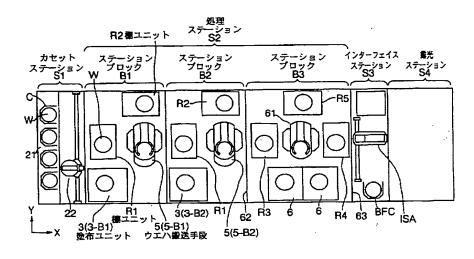


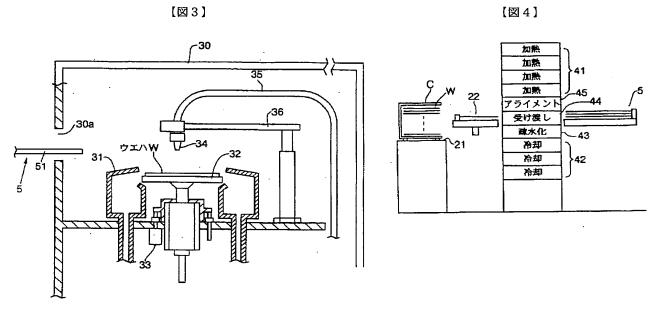
[図6]

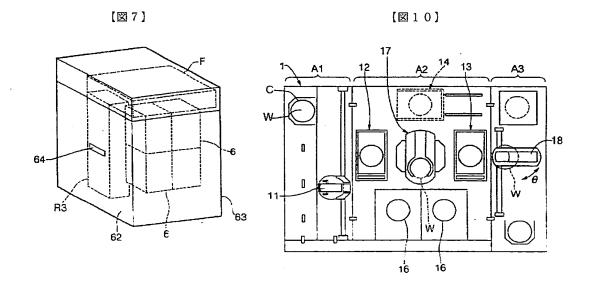




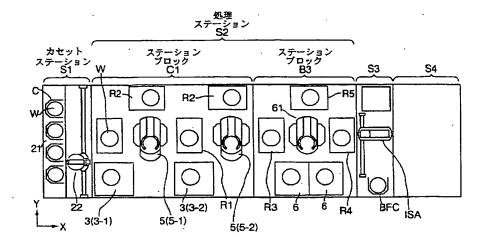
【図2】



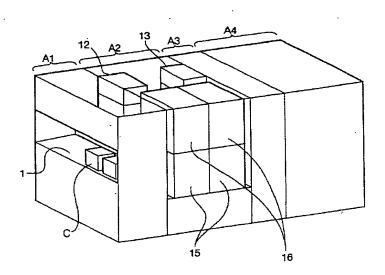




[図8]



【図9】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成13年10月26日(2001.10.26)

【公開番号】特開2000-124124 (P2000-124124A)

【公開日】平成12年4月28日(2000.4.28)

【年通号数】公開特許公報12-1242

【出願番号】特願平10-316858

【国際特許分類第7版】

H01L 21/027

G03F 7/30 502

[FI]

H01L 21/30 564 C G03F 7/30 502

【手続補正書】

【提出日】平成13年1月11日(2001.1.1.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)複数の基板を収納した基板カセットを載置する載置部と、この載置部に載置された基板カセットに対して基板の受け渡しをする受け渡し手段と、を含むカセットステーションと、このカセットステーションに接続され、前記受け渡し手段により搬送された基板を処理する処理ステーションと、を有し、

- (b) 前記処理ステーションは、複数のステーションプロックを接続してなり、各ステーションプロックは、基板を処理する処理ユニットと、この処理ユニットに対して基板の受け渡しをする基板搬送手段と、を含み、
- (c) ステーションブロックの少なくとも一つは、基板 搬送手段が自己のステーションブロックの処理ユニット と隣接のステーションブロックの処理ユニットとの両方 に対して基板の受け渡しができるように構成されている ことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】 処理ステーションは、互いに隣接して接続されるk番目(kは1以上の整数)のステーションプロックと(k+1)番目のステーションプロックとを有しており、

k番目のステーションブロックは、基板搬送手段が自己のステーションブロックの処理ユニットと (k+1)番目のステーションブロックの処理ユニットとの両方に対して基板の受け渡しができるように構成され、

k番目及び(k-1)番目のステーションプロックは、 基板搬送手段及び処理ユニットの配置のレイアウトが同 一であることを特徴とする請求項1記載の基板処理装 置。

【請求項3】 (a)複数の基板を収納した基板カセットを載置する載置部と、この載置部に載置された基板カセットに対して基板の受け渡しをする受け渡し手段と、を含むカセットステーションと、このカセットステーションに接続され、前記受け渡し手段により搬送された基板を処理する処理ステーションと、を有し、

- (b) 前記処理ステーションは、複数のステーションブロックを接続してなり、各ステーションプロックは、基板を処理する処理ユニットと、この処理ユニットに対して基板の受け渡しをする基板搬送手段と、を含み、
- (c) ステーションブロックの少なくとも一つは、平面的に互いに離れて配置された第1及び第2の処理ユニットと、これら第1及び第2の処理ユニットの両方に対して基板の受け渡しを行うことができる第1の基板搬送手段と、これら第1及び第2の処理ユニットの一方の処理ユニットに対して基板の受け渡しができるように構成された第2の基板搬送手段と、を有することを特徴とする基板処理装置。 2

【請求項4】 処理ユニットは、基板に対して塗布液を 塗布処理するものであることを特徴とする請求項1、2 または3記載の基板処理装置。

【請求項5】 前記(c)の如く構成されたステーションプロック内の処理ユニットは、レジスト液を基板に塗布処理するものであり、

カセットステーション側から数えて最終段のステーションプロック側には露光装置<u>に接続されるインターフェイスステイション</u>が接続され、当該最終段のステーションプロック内の処理ユニットは、前記露光装置にて露光された基板に対して現像処理するものであることを特徴とする請求項1、2または3記載の基板処理装置。

【請求項6】 最終段のステーションプロックは、当該ステーションブロック専用の清浄気体フィルタユニットを備えており、周囲が壁部で囲まれていてブロック内が

閉じられた空間であることを特徴とする請求項5記載の 基板処理装置。

【請求項7】 複数の基板を収納した基板カセットを載置する載置部と、この載置部に載置された基板カセットに対して基板の受け渡しをする受け渡し手段と、を含むカセットステーションと、このカセットステーションに接続され、前記受け渡し手段により搬送された基板を処理する処理ステーションと、を有し、

前記処理ステーションは、

被処理基板を搬送する進退自在なアームを備えると共に そのアームが鉛直軸周り及び上下に移動自在に構成され た搬送手段と、

前記被処理基板に加熱や冷却処理を施すユニットを複数 積層して構成された第1の棚ユニットと、

前記搬送手段の回転中心から見て前記第1の棚ユニット の方向に対して直角な方向に設けられ、前記被処理基板 に加熱や冷却処理を施すユニットを複数積層して構成さ れた第2の棚ユニットと、

前記搬送手段の回転中心から見て前記第1の棚ユニット 及び第2の棚ユニットとは別の方向に設けられ、被処理 20 基板に対して塗布処理を行う処理ユニットを複数積層し てなる処理ユニット群と、を備え、

前記搬送手段、前記第1の棚ユニット、前記第2の棚ユニット及び前記処理ユニット群を1ステーションブロックとして複数のステーションブロックを互いに接続し、 1番目のステーションブロックから最終番目のステーションブロックに至るまでの第1の棚ユニットと搬送手段との並びが一直線であることを特徴とする基板処理装置。

【請求項8】 複数のステーションブロックにおいて、 30 後段のステーションブロックにおける前記第1の棚ユニットの一のユニットに対して前段のステーションブロックの搬送手段からも基板の受け渡しを行うことができるように構成されていることを特徴とする請求項7記載の基板処理装置。

【請求項9】 第1番目のステーションブロックにおける前記第1の棚ユニットの一のユニットに対して前記カセットステーションの受け渡し手段からも基板の受け渡しを行うことができるように構成されていることを特徴とする請求項7または8記載の基板処理装置。

【請求項10】 前記第1の棚ユニットは上部側に加熱 ユニットが設けられ、下部側に冷却ユニットが設けられ ていることを特徴とする請求項7.8または9記載の基 板処理装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】これら発明において、処理ユニットは、例 えば基板に対して塗布液を塗布処理するものである。具 体例を挙げると、前記(c)の如く構成されたステーシ ョンブロック内の処理ユニットは、レジスト液を基板に **塗布処理するものであり、カセットステーション側から** 数えて最終段のステーションブロック側には露光装置が 接続され、当該最終段のステーションプロック内の処理 ユニットは、前記露光装置にて露光された基板に対して 現像処理するものである構成である。この場合、最終段 のステーションブロックは、当該ステーションブロック 専用の清浄気体フィルタユニットを備えており、周囲が 壁部で囲まれていてブロック内が閉じられた空間である 構成とすることができる。 また他の発明は、複数の基板 を収納した基板力セットを載置する載置部と、この載置 部に載置された基板力セットに対して基板の受け渡しを する受け渡し手段と、を含むカセットステーションと、 このカセットステーションに接続され、前記受け渡し手 段により搬送された基板を処理する処理ステーション と、を有し、前記処理ステーションは、被処理基板を搬 送する進退自在なアームを備えると共にそのアームが鉛 直軸周り及び上下に移動自在に構成された搬送手段と、 前記被処理基板に加熱や冷却処理を施すユニットを複数 積層して構成された第1の棚ユニットと、前記搬送手段 の回転中心から見て前記第1の棚ユニットの方向に対し て直角な方向に設けられ、前記被処理基板に加熱や冷却 <u>処理を施すユニットを複数積層して構成された第2の棚</u> ユニットと、前記搬送手段の回転中心から見て前記第1 <u>の棚ユニット及び第2の棚ユニットとは別の方向に設け</u> られ、被処理基板に対して塗布処理を行う処理ユニット を複数積層してなる処理ユニット群と、を備え、前記搬 送手段、前記第1の棚ユニット、前記第2の棚ユニット <u>及び前記処理ユニット群を1ステーションプロッ</u>クとし て複数のステーションプロックを互いに接続し、1番目 40 のステーションブロックから最終番目のステーションブ ロックに至るまでの第1の棚ユニットと搬送手段との並 びが一直線であることを特徴とする。